

## สรุปผลการทดลอง

1. แวนพลีกซิลิกอนที่ผ่านการขัดผิวนคราจะมีสภาพผิวชำรุดเกิดขึ้น อันประกอบด้วยรอยแตกร้าว ติสโลเคชั่น และ Elastic Strain และเมื่อนำแวนพลีกเทล่ามีไปประดิษฐ์เป็นเซลแสงอาทิตย์ ปรากฏว่าลักษณะสมบัติกราฟ-แรงตัวของเซลฯเปลี่ยนไป กล่าวคือ

ก.  $I_{sc}$  มีค่าสูงขึ้นในช่วงแรก เนื่องจากค่าการสะท้อนแสงมีค่าลดลง เป็นผลให้ค่าไฮล-อิเล็คตรอนเกิดมากขึ้น และ  $I_{sc}$  มีค่าลดลงในช่วงหลัง เนื่องจากติสโลเคชั่นประพฤติตัวเป็น Surface Recombination Center

ข.  $V_{oc}$  มีค่าลดลงเนื่องจากติสโลเคชั่นในบริเวณเขตปลดพาหะประพฤติตัวเป็น Intermediate Center เป็นผลให้ค่ากระแสเม็ดและค่ากระแสอยู่ตัวบัญญากับมีค่าสูงขึ้น ส่งผลให้  $V_{oc}$  มีค่าลดลงอีกทอดหนึ่ง

ค. FF. มีค่าลดลง ทั้งนี้เนื่องจากขั้นผิวชำรุดก่อให้เกิด  $R_{sh}$  ที่มีค่าต่ำลงและติสโลเคชั่นในพลีก ก่อให้เกิด  $R_s$  ที่มีค่าสูงขึ้น FF. จึงลดลง ยกเว้นในกรณีที่กระแสทางแสงลดลงอย่างรวดเร็วมาก

ง. ประสิทธิภาพของเซลฯลดลงตามค่า  $V_{oc}$  และ FF. ที่ลดลง

2. แวนพลีกที่ผ่านการขัดผิวน้ำด้วยเครื่องขัด จะมี Cellular Structure แตกต่างกัน Specular Reflection และ Diffused Reflection จะต่างกันไปตามขนาดของผงขัดและเวลาในการขัด แต่ค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดกลืนแสงยังคงเท่าเดิม ดังนั้นเมื่อนำแวนพลีกเทล่ามีมาประดิษฐ์เป็นเซลแสงอาทิตย์ ลักษณะสมบัติกราฟ-แรงตัวจึงคล้ายกัน ค่า  $I_{sc}$ ,  $V_{oc}$ , FF. และ  $\eta$  มีค่าใกล้เคียงกัน

จากข้อสรุป 2 ข้อข้างต้น แสดงว่าเซลแสงอาทิตย์สามารถทำจากแวนพลีกสารกึ่งตัวนำที่มีสภาพผิวเข็นไว้ได้ แต่ต้องไม่มีสภาพผิวชำรุด ดังนั้นแวนพลีกที่ผ่านการขัดบาง (Lapping) และ

กัด เอาสภาพชำรุดออกด้วยสารเคมี ก็สามารถใช้ทำเซลล์ได้ติดอยู่กับแวนน์ฟลีกที่ผิวมันเป็นกระจก และการใช้แวนน์ฟลีกผิวหยาบเนื้อจะลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก

การใช้แวนน์ฟลีกที่มีผิวหยาบเพื่อทำเซลล์แสงอาทิตย์มีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายแบบเพื่อกัดอัลู-มิเนียมอย่างบ้าง เป็นองจากสังเกต漉ด้ายของขันอักไขด้วนที่ใช้เป็นขันต้านการสะท้อนแสงได้ไม่ชัด เช่น แต่สามารถที่ลีกเลี้ยงปัญหานี้ได้ โดยการขัดผิวแวนน์ฟลีก ด้วยผงขัดขนาดเล็ก (Micropowder) เป็นเวลา 5-10 นาที ด้วยเครื่องขัดบนฐานรองรับที่อ่อนนุ่ม เพื่อลดค่า Diffused Reflection ทำให้สามารถเห็นแนวของโลหะอัลูมิเนียมที่ต้องการกัดออกได้